2024年3月期第3四半期(2023年4月~12月) 決算説明資料

2024年2月9日 株式会社 KOKUSAI ELECTRIC

KOKUSAI ELECTRIC CORPORATION and its Affiliates Proprietary Copyright © KOKUSAI ELECTRIC Corporation 2024. All rights reserved.

本日 15 時に公表させていただきました、4 月 1 日付の弊社役員人事につきまして、簡単にご説明させていただきます。

今回の趣旨は、上場の完了を受け、この先 10 年をめざして一貫した経営体制を構築することです。ぜひ ご理解をいただけますようお願いいたします。

なお、執行役員を退任いたします神谷と小川につきましても、それぞれ取締役、取締役 エグゼクティブ・フェローとして、継続して弊社の経営に関与してまいります。

2024年3月期第3四半期連結決算概要

- 半導体デバイスの在庫調整が進み、メモリーデバイス単価の上昇も見られ始めたことから、市況は底を打ったと認識。 成熟ノードへの活発な投資に加え、DRAM、Logic/Foundryも回復基調へ。
- 当社3Qは前年同期比で減収減益ながら、売上・利益は1Q<2Q<3Qと回復が顕著。 受注も計画通り3Qから回復。

2024年3月期連結業績予想と今後の見通し

- ■24/3期の装置売上は23/3期比で大きく減少するものの、25/3期はWFEを上回る成長を想定。
- 当社売上・利益は1Qを底に、受注は2Qを底に回復に転じており、24/3期通期予想に変更なし。 成熟ノード向け投資が活発で売上収益を下支え。今後は先端デバイス向けも回復へ。
- 令和6年能登半島地震による業績への影響は軽微。

KOKUSAI ELECTRIC

KOKUSAI ELECTRIC CORPORATION and its Affiliates Proprietary

4ページはハイライトです。具体的な内容は、次のページ以降でご説明します。

3Qはメモリー市場低迷の影響により前期比で減収減益ながら、売上・利益は1Q<2Q<3Qと回復が顕著。 案件構成変化の影響はあったものの、売上総利益率は40%以上を持続。

	0.0	23/3	期					24/3期	0.1		100
(億円)	1Q	2Q	3Q	3Q累計	1Q	2Q	3Q	前年同期比	前四半期比	3Q累計	前年同期比
売上収益	560	644	652	1,856	327	450	540	△17.3%	+19.9%	1,317	△29.1%
売上総利益	231	275	264	769	143	199	217	△17.5%	+9.3%	559	△27.3%
売上総利益率	41.2%	42.7%	40.4%	41.4%	43.6%	44.2%	40.3%	△0.1pts	∆3.9pts	42.5%	+1.0pts
調整後営業利益	147	181	172	500	56	110	124	△27.7%	+12.4%	290	△41.9%
調整後営業利益率	26.2%	28.1%	26.3%	26.9%	17.2%	24.5%	23.0%	∆3.3pts	△1.5pts	22.1%	△4.8pts
調整後四半期利益	108	125	122	355	38	73	91	△25.4%	+24.6%	202	△43.1%
調整後四半期利益率	19.3%	19.4%	18.7%	19.1%	11.6%	16.2%	16.9%	∆1.8pts	+0.6pts	15.3%	∆3.8pts
営業利益	130	164	155	449	40	94	107	△31.2%	+13.9%	241	△46.4%
営業利益率	23.2%	25.5%	23.8%	24.2%	12.2%	20.9%	19.8%	△4.0pts	△1.0pts	18.3%	△5.9pts
税引前四半期利益	129	164	157	450	37	91	107	△31.4%	+17.5%	236	△47.5%
税引前四半期利益率	23.0%	25.5%	24.0%	24.2%	11.4%	20.3%	19.9%	△4.1pts	△0.4pts	17.9%	△6.3pts
四半期利益	96	113	111	320	27	62	79	△28.5%	+28.5%	167	△47.7%
四半期利益率	17.1%	17.5%	17.0%	17.2%	8.1%	13.7%	14.7%	△2.3pts	+1.0pts	12.7%	△4.5pts
研究開発費	27	33	29	89	29	30	31	+5.2%	+1.3%	90	+1.4%
設備投資	7	29	22	57	51	21	105	3.9倍	4.1倍	176	2.1倍
減価償却費	25	26	26	77	26	27	28	+7.4%	+4.5%	81	+5.3%

KOKUSAI ELECTRIC

KOKUSAI ELECTRIC CORPORATION and its Affiliates Proprietary
Convright © KOKUSAI FLECTRIC Corporation 2024. All rights reserve

5ページをご覧ください。ここでは、第3四半期と第3四半期累計の損益を示しています。

当社では、調整後の利益を重要な経営指標と位置付けているため、調整後の利益で説明します。なお、当社製品の輸出売上は、ほとんどが円建てで行われるため、利益に対する為替影響は軽微です。

第3四半期は、売上収益が前年同期比で17%減、調整後営業利益は28%減となりました。

市場変化に比べて減少幅が大きいのは、当社のメモリー売上構成比が大きく、メモリー市場低迷の影響が色濃く表れたためです。

一方、第2四半期との比較では、売上収益が20%増、調整後営業利益が12%増となり、Quarter on Quarter ではさらに回復しました。想定通り、第1四半期で底を打ち、第2四半期、第3四半期と回復基調が顕著に表れました。案件構成の変化により、売上総利益率は第1四半期、第2四半期より低下していますが、40%以上を維持しています。

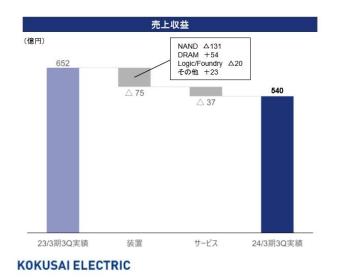
第3四半期累計では、売上収益が前年同期比で29%減と当初の想定通りとなりました。調整後営業利益は42%減と引き続き当初の想定を上回って推移しています。

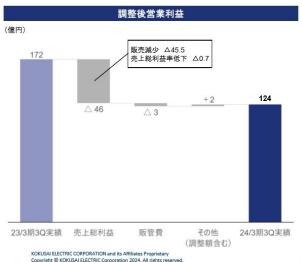
研究開発費、設備投資額、減価償却費は当初の想定通りに進捗しています。

.

2024年3月期第3四半期実績 增減要因

NANDに対する投資抑制により、売上収益は前年同期比▲113億円。 販売減少の影響により、調整後営業利益は前年同期比▲48億円。





6ページは、第3四半期の売上収益と調整後営業利益の前年同期比での増減要因です。

第1四半期、第2四半期と同様、NANDに対する投資抑制を受けて、第3四半期も装置売上が大きく減少しました。この販売減少に伴って売上総利益が減少し、調整後営業利益が減少しました。

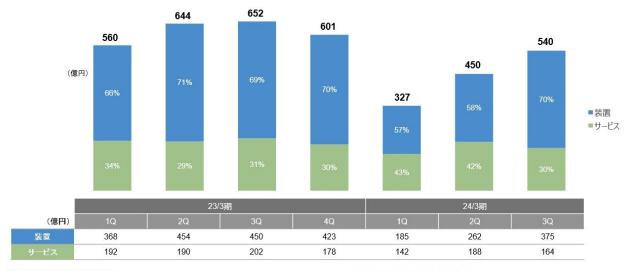
第3四半期は、中国での成熟ノードへの活発な投資に加え、中国以外での DRAM、Logic/Foundry も回復に転じています。

第3四半期累計での装置・サービスを合わせた中国向け売上比率は全体の44%となりましたが、今後は中国以外での売上回復に合わせて、本来の水準である30%程度に近づいていく見通しです。

また、第3四半期累計での装置売上に占める主力装置の売上は、バッチ ALD が約5割、トリートメントが約1割でした。

売上収益 ビジネス別

3Qのビジネス別売上構成は、装置売上の回復により装置:サービス=70%:30%に平常化。



KOKUSAI ELECTRIC

KOKUSAI ELECTRIC CORPORATION and its Affiliates Proprietary
Copyright © KOKUSAI ELECTRIC Corporation 2024. All rights reserved

ts reserved.

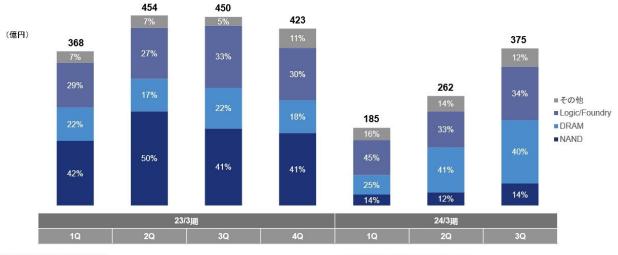
7ページは、ビジネス別売上収益の推移です。

23年3月期通期は、装置が7割、サービスが3割でした。

24年3月期に入って装置売上が減少する中、サービスは前年同期並みの売上収益を持続していることから、サービスの売上構成比が増加していますが、第3四半期は装置売上が回復し、本来の売上構成比に戻りました。

売上収益 アプリケーション別(装置のみ)

3Qのアプリケーション別売上構成は、NANDへの投資抑制が続く中、成熟ノードを含むDRAM、Logic/Foundryへの投資回復により、NAND: DRAM: Logic/Foundry+その他=14%: 40%: 46%。



KOKUSAI ELECTRIC

CUSAL ELECTRIC CORPORATION and its Affiliates Proprietary

8

8ページは、アプリケーション別売上収益の推移です。

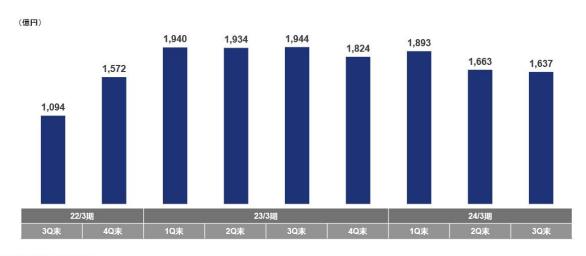
23 年 3 月期通期では NAND が 43%、DRAM が 20%、Logic その他が 37%でした。

24年3月期に入って、NANDが減少する中、第2四半期から中国での成熟ノードへの活発な投資が業績の下支えとなっていますが、第3四半期からは中国以外でのDRAM、Logic/Foundryも回復に転じています。NANDについても、デバイスメーカー各社は先端開発を継続しており、開発用装置売上は一定の規模を保っています。

なお、その他は、ウェーハ用途、Si パワーデバイス用途などで構成されており、ウェーハサイズ 150~200mm の SiC パワーデバイス用途はサービスビジネスに含んでいます。

受注残高の推移

受注は計画通り2Qを底に3Qから回復。長納期案件の売上転換も進み、受注残高は平常化へ。 その結果、3Q末の受注残高は2Q末と概ね同水準。



KOKUSAI ELECTRIC

OKUSAI ELECTRIC CORPORATION and its Affiliates Proprietary

9ページは、受注残高の推移です。

第3四半期末の受注残高は1,637億円と、第2四半期末と同等の水準となりました。受注高は当初の想定通り第2四半期で底を打ち、第3四半期から回復しています。また、22年3月期後半のサプライチェーン問題を受けて長納期案件が増加し、受注残高が高止まりしていましたが、当初の想定通り、長納期案件が売上に転換さればじめました。

これらにより、第3四半期は受注高と売上収益が同水準となり、受注残高は平常化へ向かっています。

第3四半期末の受注残高の約3割が当期、約6割が来期、残り1割がそれ以降に売上計上される予定です。

貸借対照表

資産合計は、現金・現金同等物、営業債権等が減少したものの、有形固定資産、棚卸資産が増加し、 23/3期末比と概ね同水準。

負債合計は、主に営業債務等、借入金の減少により、23/3期末比で185億円減少。



10ページはバランスシートです。

資産合計は、現金及び現金同等物、営業債権及びその他の債権が減少したものの、大型設備投資に伴う 有形固定資産の増加、需要回復を見据えた棚卸資産の増加により、23年3月期末と概ね同水準となりま した。

負債合計は、主に営業債務及びその他の負債の減少により、23年3月期末比で185億円減少しました。

自己資本比率&現金及び現金同等物/有利子負債

自己資本比率は、3Q末で48.6%に増加。

24/3期は営業CFの悪化により、3Q末のネットデットは95億円。有利子負債は引き続き減少。





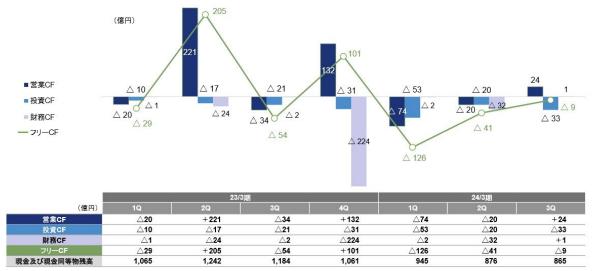
KOKUSAI ELECTRIC

11ページはバランスシートの主な経営指標の推移です。

自己資本比率は前期末から約5ポイント上昇し、48.6%となりました。

キャッシュとデットの関係については、24年3月期の営業キャッシュ・フローが悪化している影響で、ネット キャッシュが一時的にマイナスになっていますが、売上収益の回復とともに営業キャッシュ・フローは良化 し、来期以降、ネットキャッシュはプラスに転じる見込みです。

3Qは売上収益の回復に伴って営業CFが回復。現金・現金同等物の四半期末残高は高水準を持続。



KOKUSAI ELECTRIC

KOKUSAI ELECTRIC CORPORATION and its Affiliates Proprietary
Converient © KOKUSAI FLECTRIC Corporation 2024. All rights reserve

45

12ページは四半期ごとのキャッシュ・フローの推移です。

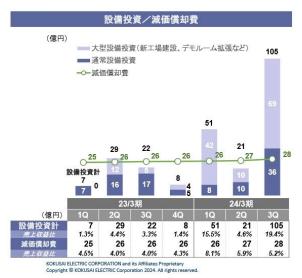
営業キャッシュ・フローは売上収益の減少に伴って減少していますが、第3四半期の営業キャッシュ・フローはプラスに転じました。

現金及び現金同等物残高は運転資金として十分な水準を維持しています。

研究開発費/設備投資/減価償却費

次世代製品開発のための投資継続により、研究開発費比率は一時的に増加。売上回復に伴って平常化へ。 新工場建設やデモルーム拡張など長期償却の大型設備投資が増加。





KOKUSAI ELECTRIC

13ページは、四半期ごとの研究開発費、設備投資額、減価償却費の推移です。

当社では、今後の需要回復と中長期的な需要拡大を見据えて、研究開発投資、設備投資を継続しているため、足元での売上減少により売上収益に占める研究開発費、設備投資額の比率は一時的に上昇しています。

研究開発費については従来、売上収益の $4\sim5\%$ で推移していましたが、中長期的には 6%程度へ引き上げます。また、設備投資については、従来年間 $20\sim30$ 億円で推移していましたが、今後は年間 $40\sim60$ 億円に引き上げます。

第3四半期の設備投資については、富山県に建設している新工場関連の投資、韓国でのデモルーム拡張など大型設備投資が計上され、一時的に大きな金額になっています。また、韓国でのデモルーム拡張に伴って評価装置を設置するなど、通常設備投資も一時的に増加しています。

13

2024年3月期第3四半期連結決算概要

- 半導体デバイスの在庫調整が進み、メモリーデバイス単価の上昇も見られ始めたことから、市況は底を打ったと認識。 成熟ノードへの活発な投資に加え、DRAM、Logic/Foundryも回復基調へ。
- 当社3Qは前年同期比で減収減益ながら、売上・利益は1Q<2Q<3Qと回復が顕著。 受注も計画通り3Qから回復。

2024年3月期連結業績予想と今後の見通し

- ■24/3期の装置売上は23/3期比で大きく減少するものの、25/3期はWFEを上回る成長を想定。
- 当社売上・利益は1Qを底に、受注は2Qを底に回復に転じており、24/3期通期予想に変更なし。 成熟ノード向け投資が活発で売上収益を下支え。今後は先端デバイス向けも回復へ。
- 令和6年能登半島地震による業績への影響は軽微。

KOKUSAI ELECTRIC

KOKUSAI ELECTRIC CORPORATION and its Affiliates Proprietary

Converget © KOKUSAI FLECTRIC Corporation 2024. All rights reserved.

45

続いて、通期業績予想と今後の見通しです。

15ページはハイライトです。具体的な内容は、次のページ以降でご説明します。

2024年3月期業績予想

通期業績予想に変更なし。

成熟ノードを含むDRAM、Logic/Foundryへの投資が業績を下支え。

	23/3期		24/3期			
(億円)	3Q累計	通期	3Q累計	通期(予想)	前期比	
売上収益	1,856	2,457	1,317	1,800	△26.7%	
売上総利益	769	1,008	559	737	△26.9%	
売上総利益率	41.4%	41.0%	42.5%	40.9%	△0.1pts	
調整後営業利益	500	643	290	363	△43.6%	
調整後営業利益率	26.9%	26.1%	22.1%	20.1%	△ 6.0pts	
調整後当期(四半期)利益	355	460	202	252	△45.3%	
調整後四半期利益率	19.1%	18.7%	15.3%	14.0%	∆4.7pts	
営業利益	449	561	241	291	△48.1%	
営業利益率	24.2%	22.8%	18.3%	16.2%	△6.6pts	
税引前四半期利益	450	559	236	283	△49.4%	
税引前四半期利益率	24.2%	22.7%	17.9%	15.7%	△7.0pts	
当期(四半期)利益	320	403	167	202	△49.9%	
四半期利益率	17.2%	16.4%	12.7%	11.2%	∆5.2pts	
1株当たり配当金(円)		-	-	11*1		
配当性向		-	-	12.5%		

*1 24/3期予想の1株当たり配当金につきましては、上場時期が下半期であることを踏まえて半期分の金額とし、全額期末配当による支払いを予定しております。

KOKUSAI ELECTRIC

KOKUSAI ELECTRIC CORPORATION and its Affiliates Proprietary
Convigent © KOKUSAI ELECTRIC Corporation 2024, All rights reserved

40

16ページをご覧ください。

上場時に公表した24年3月期業績予想に変更はありません。

第3四半期までの利益は当初予想を上回っていますが、通期予想は据え置いており、通期業績予想の各利益はミニマムの水準と捉えています。

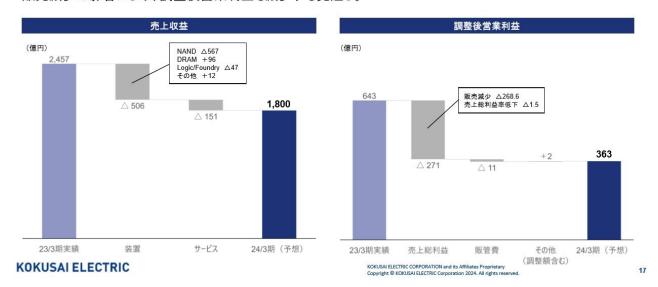
なお、当社グループは富山県内に富山事業所とグループ会社拠点を有していますが、今年1月1日に発生した令和6年能登半島地震による甚大な被害はなく、1月9日より通常業務を順次開始しています。そのため、当社業績への影響は軽微です。

配当予想にも変更はなく、上場時期が下半期であることを踏まえて半期分の金額とし、全額期末配当による支払いを予定しています。

配当性向は調整前の当期利益をベースにした数値を記載していますが、調整後当期利益をベースに算出すると 10%となり、年間では 20%に相当する水準となります。

2024年3月期業績予想 增減要因

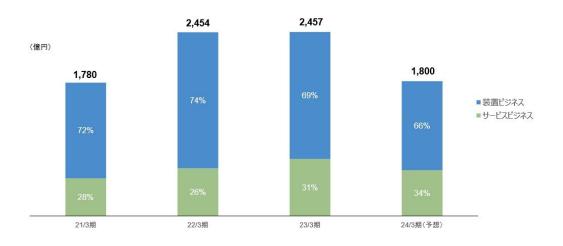
NANDに対する投資抑制の影響により、装置売上が減少する見通し。 販売減少の影響により、調整後営業利益も減少する見通し。



17ページでは、通期業績予想を前期実績と比較した場合の増減要因を示しています。

第4四半期も、第2四半期から続いている中国での成熟ノードへの活発な投資が持続することに加えて、第3四半期から回復に転じている中国以外でのDRAM、Logic/Foundryへの投資が当社業績をけん引する見通しです。NANDについても、開発用装置売上を含めて一定の規模を保つ見通しです。

24/3期は、装置売上の減少により、サービスビジネスの比率が一時的に拡大する見通し。



KOKUSAI ELECTRIC

KOKUSAI ELECTRIC CORPORATION and its Affiliates Proprietary
Convrient © KOKUSAI FLECTRIC Corporation 2024. All rights reserve

41

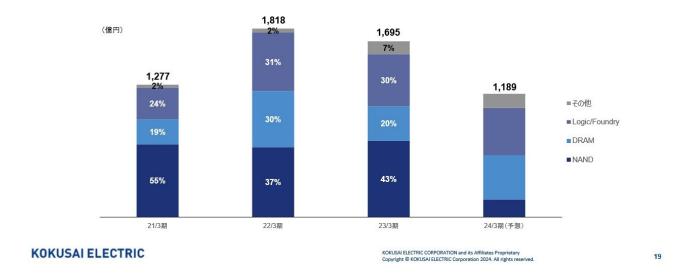
18ページは、通期でのビジネス別売上構成の推移です。

24年3月期は装置売上の減少により、サービスビジネスの比率が一時的に拡大するものと見込んでいますが、装置売上の回復に伴い、従来のバランスに戻ると見込んでいます。

中長期的には、装置、サービスのそれぞれを成長させることにより、装置売上 70~75%、サービス売上 25~30%のバランスをめざします。

売上収益予想 アプリケーション別(装置のみ)

24/3期は、NANDへの投資抑制が続く中、成熟ノードを含むDRAM、Logic/Foundryへの投資回復により、DRAMとLogic/Foundryの比率が上昇する見通し。



19ページは、通期での装置売上のアプリケーション別売上構成の推移です。

24 年 3 月期は NAND への投資抑制により、DRAM、Logic/Foundry 比率が一時的に上昇するものと見込んでいますが、中長期的には、それぞれを拡大し、NAND30%、DRAM30%、Logic/Foundry とその他で 40%のバランスをめざします。

20ページからは今後の見通しになります。

半導体デバイス・WFE市場の見通し

- 半導体デバイス市場
 - 中長期的には、5G、AI、IoT、DXの拡がりによるデータセンターの拡充や環境負荷低減への投資(GX)等により、大きな成長が見込まれる。
- WFE市場
 - 24年は23年並みを見込み、今後数年でUSD 110~120bn 程度まで成長すると想定。
 - 半導体デバイスの複雑化・三次元化に伴い、付加価値の高い半導体製造装置の需要拡大が期待される。
 - 中国における成熟ノードへの活発な投資は持続すると想定されるものの、当社は慎重な見方を継続。今後はグローバル市場が回復基調へ。

24/3期及び25/3期の装置売上見通し

- 24/3期の装置売上は23/3期比で大きく減少するものの、1Qを底に回復が顕著。25/3期はWFEを上回る成長を想定。
- アプリケーション別のトレンド

DRAM	・最も安定した受注・売上を想定。中国向け成熟ノードの需要増加に加え、グローバルでの先端デバイスの需要増加を見込む・生成AIの普及によるHBM*1需要拡大の後押しもあり、DRAMの需要拡大が期待される。			
Logic/Foundry	・足元では中国向け成熟ノードが牽引し、その後はグローバルでの先端デバイス向けの量産立ち上がりを見込む。 ・GAA ^{*2} の開発用途POR ^{*3} の獲得も進んでおり、25/3期から売上貢献しはじめ、その後の需要拡大が期待される。			
NAND	・足元では開発用途装置の需要持続を見込む。 ・市況は25/3期後半から回復に転じ、26/3期での本格的な量産回復が期待される。			
SiCパワーデバイス	・24/3期、25/3期は既存製品で売上拡大を見込む。 ・26/3期以降は高温活性化アニール新製品での急成長が期待される。			

*1 HBM: High Bandwidth Memory (高帯域幅メモリー)の略 *2 GAA: Gate All Aroundの略 *3 POR: Process of Recordの略で、顧客の半導体製造プロセスにおける製造装置認定を指す。

KOKUSAI ELECTRIC

KOKUSAI ELECTRIC CORPORATION and its Affiliates Proprietary

常務執行役員の塚田です。ここからは私が説明いたします。

半導体デバイス市場は、データセンターの拡充や環境負荷低減への投資、いわゆる GX 等により、中長期的に大きな成長が見込まれています。WFE 市場は、24 年こそ 23 年並みを見込むものの、今後数年で1,100 から 1,200 億ドル程度の規模まで成長すると見ています。

当社の24/3期の装置売上は、前期から大きく減少する見通しですが、25年3月期は24年3月期比でWFEを上回る、20%程度の成長を想定しています。中国の成熟ノードへの活発な投資は今後も持続するものの、当社では25/3期下期以降、慎重な見方をしています。

続いてアプリケーション別の見通しです。

DRAM は、最も安定した受注・売上を想定しており、中国向け成熟ノードの需要増加に加え、グローバルでの先端デバイスの需要増加を見込んでいます。生成 AI の普及による HBM 需要拡大の後押しもあり、 DRAM の需要拡大が期待されます。

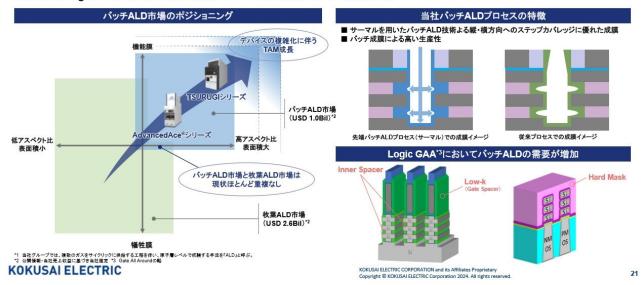
Logic/Foundry は、足元では中国向け成熟ノードが牽引し、その後はグローバル市場での先端デバイス向けの量産立ち上がりを見込んでいます。 GAA の開発用途 POR の獲得がさらに進み、すべての大手メーカーから POR を獲得しました。 現時点での GAA 関連の受注見込みは 100 億円に手が届く規模になっており、25 年 3 月期から売上貢献しはじめ、その後の需要拡大が期待されます。

NAND は、25 年 3 月期後半から市況が回復に転じ、26 年 3 月期での本格的な量産回復が期待されます。

SiC パワーデバイスは、既存製品の需要増加により24年3月期に前期比8倍前後の成長を見込んでいます。25年3月期は高温活性化アニール新製品を評価用に納入し、24年3月期比で20%以上の売上拡大を見込んでいます。さらに、26年3月期以降は新製品の量産による急成長が期待されます。

バッチALDの優位性

デバイスの複雑化に伴い、バッチALD*1市場は拡大。枚葉ALD市場とすみ分けながら、NANDのみならずDRAM、LogicでもバッチALDに対するニーズは強まっていく見通し。



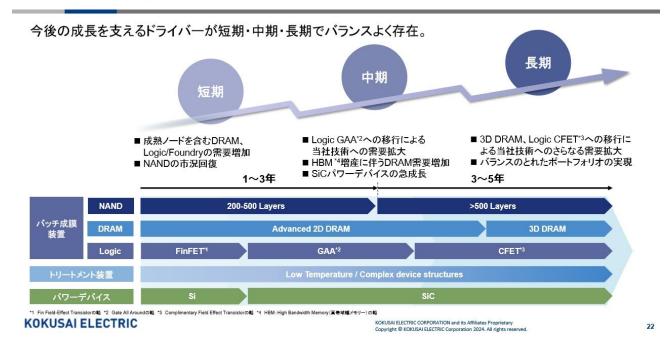
21 ページでは、バッチ ALD 市場の見通しをまとめています。

左側の図をご覧ください。バッチと枚葉は別々のアプリケーションで使用されており、両者の領域はほとんど重複していません。半導体デバイスがより複雑になるにつれて、生産性の課題が顕著になり、バッチALDに対するニーズは拡大しています。これにより、バッチALD市場は右上の方向に拡大しています。

右上の図は当社のバッチ ALD プロセスの特徴を示しています。当社のバッチ ALD はサーマルを用い、サイクリックにガスを供給することにより、高い生産性で、縦方向だけでなく横方向にもステップカバレッジに優れた成膜を行うことができます。 次世代 Logic GAA では、縦方向にも横方向にも均一に質の高い成膜を行う必要があり、当社のバッチ ALD が最適なソリューションになると考えています。

右下の図は、Logic GAA で、Low-k に加え、当社のバッチ ALD を生かすことができる Inner Spacer、Hard Mask を示したものです。いずれも非常に複雑な構造ですが、当社のバッチ ALD 技術の優位性を生かし、ステップカバレッジに優れた成膜を行うことができます。GAA から CFET へ移行すれば、バッチ ALD が優位となる工程がさらに増えるものと期待しています。

今後のビジネス展開



22ページには、当社の開発ロードマップとともに、当社の今後の成長を支えるドライバーをまとめました。

当社では、半導体デバイスの多層化、複雑化、三次元化が進むにつれ、NAND、DRAM、Logic のそれぞれで、当社が得意とするバッチ ALD とトリートメントが生かせる機会が増加していくと考えています。

短期では、成熟ノードを含む DRAM、Logic/Foundry の需要増加、それに続く NAND の市況回復。中期では、Logic GAA での量産 POR 獲得による売上拡大、HBM 増産に伴う先端 DRAM の需要増加、SiC パワーデバイス向けの新製品投入による急成長。そして長期では、3D DRAM や Logic CFET への移行などの変曲点が存在しており、それぞれで需要に見合う製品・サービスを提供することにより、バランスのとれたポートフォリオを実現し、中長期的な成長をめざしていきます。

説明は以上となります。